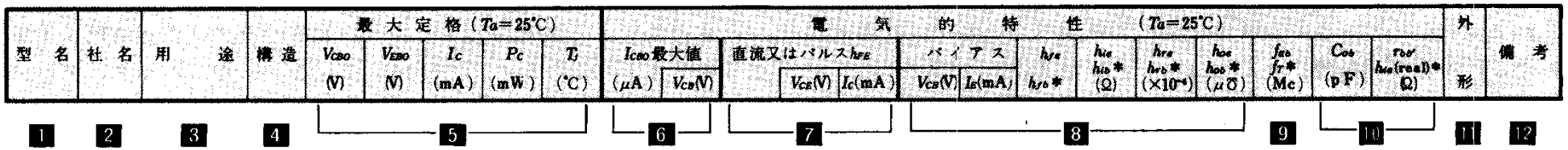
FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.



1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

：とコンプリ： COMPLEMENTARY TO ·····

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)														外形	備考
					V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)		
★	2SC183	日電	RF.Conv.Mix Osc. AF	Si. E	20	5	30	100	125	0.1	15	75	3	0.5	6	−1	80	2000	0.55	10	150*	1.6	50*	23	
★	〃 184	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	5	30	100	125	0.1	15				6	−1	80				200*	1.6	50*	23	
★	〃 185	〃	〃	〃	20	5	30	100	125	0.1	15				6	−1	80				250*	1.6	50*	23	
★	〃 186	富士通	〃	Si. P	20	2	25	85	120	2	12				6	−2.5	40				200*	4	35	12A	
★	〃 187	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	20	2	25	85	120	2	12				6	−2.5	50				200*	4	50	12A	
★	〃 188	〃	RF. PA	〃	40	3	500	600	175	1	30	40	10	150	6	−10	50				150*	9	35	84B	
★	〃 189	〃	RF. SW. PA	〃	60	5	500	600	175	1	30	40	10	150	6	−10	50				150*	9	35	84B	
★	〃 190	〃	〃	〃	60	5	500	600	175	1	30	75	10	150	6	−10	80				180*	9	35	84B	
★	〃 191	ソニー	RF	Si. GD	60	1	10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84A	
★	〃 192	〃	〃	〃	60	1	10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	10	3	200	84A	
★	〃 193	〃	〃	〃	60	1	10	250	150	2	60				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	30	3	200	84A	
★																									
★	〃 195	〃	〃	〃	30	1	10	250	150	1	30				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	10	3	200	84A	
★	〃 196	〃	〃	〃	30	1	10	250	150	1	30				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	30	3	200	84A	
★	〃 197	〃	〃	〃	30	1	10	250	150	1	30				20	−1	−0.955*	60*	1.2*	0.15*	50	3	200	84A	
★	〃 198	富士通	RF. PA	Si. EP	50	5	500	800	175	1	10				10	−20	40				350*	6	50*	85C	
★	〃 199	東芝	SW	Si. Me	80	15	50	600	175	0.1	15	70	12	3	12	−3	70	h_{fe} = 2 (f = 50 MHz)				2	100	84B	
	〃 200	富士通	RF.Conv.Mix Osc. PA	Si. EP	40		300	650	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	84C	
★	〃 201	〃	〃	〃	20		300	650	175	0.1	10				6	−1	60				350*	4	50*	84C	
	〃 202	〃	〃	〃	80		300	650	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	84C	
	〃 203	〃	〃	〃	40		200	350	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	49C	
	〃 204	〃	RF. SW	〃	30	5	200	350	175	0.05	10	60	1	10	6	−2	70	t_r < 20nS, t_f < 50nS t_s < 250nS			250*	4	80*	49C	
	〃 205	〃	RF. Conv. Mix Osc. PA	〃	80		200	350	175	0.02	10				6	−1	60				350*	4	50*	49C	
★	〃 206	〃	〃	Si. P	20	2	25	200	175	2	12				6	−2	35				200*	2	80*	50C	
★	〃 207	〃	〃	〃	20	3	25	200	175	0.1	12				6	−2	80				800*	1.0	80*	50C	
★	〃 208	〃	〃	〃	20	3	25	200	175	1	12				6	−2	60				550*	1.2	80*	50C	
★	〃 209	〃	〃	〃	20	3	25	200	175	1	12				6	−2	40				450*	1.2	80*	50C	
★	〃 210	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	50		500	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	84B	
★	〃 211	〃	RF	〃	25		500	650	175	1	10				10	−20	50				150*	15	35*	84B	
★	〃 212	〃	〃	〃	80		500	650	175	0.1	10				10	−20	50				150*	15	35*	84B	